В начало Курсы ФИиВТ 09.03.04 Программная инженерия(Очная) ПС 11 Разработка программных систем 4 семестр

(09.03.04 11 4 сем о)Физика Дополнительные виды работ Вентильный фотоэффект (защита)

Тест начат Пятница, 14 Июнь 2024, 17:00

Состояние Завершенные

Лрошло 4 мин. 44 сек.

Времени

Баллы 4,00/5,00

Оценка 3,20 из 4,00 (80%)

Вопрос 1

Верно
Баллов: 1,00 из 1,00

Приведите в соответствие выражения, приведенные ниже:

Если валентная зона при T=0°K **частично заполнена** электронами, то это ...

Если валентная зона при T=0°К **полностью заполнена** электронами, а ширина запрещенной зоны **менее 2 эВ**, то это ...

полупроводник

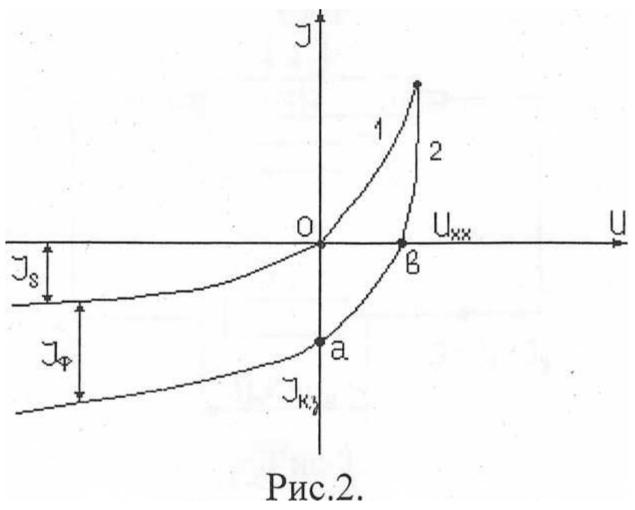
металл

Ваш ответ верный.

Вопрос 2
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
На рисунке представлена схема энергетических зон полупроводника $n$ – типа.
Буква А обозначает
Выберите один ответ:
<ul><li>валентную зону</li></ul>
О донорный уровень
уровень Ферми при T = 0 K
зону проводимости
<ul><li>уровень Ферми при Т больше 0 К</li></ul>
Ваш ответ верный.
Вопрос 3
Неверно
Баллов: 0,00 из 1,00
Укажите верные утверждения для собственного полупроводника:
Выберите один или несколько ответов:
☑ При повышении температуры концентрации электронов и дырок одинаковы ✔
У Энергия активации заряда равна половине ширины запрещенной зоны ★
Энергия активации заряда равна ширине запрещенной зоны
При повышении температуры концентрации электронов и дырок зависят от химического состава полупроводника
Ваш ответ неправильный.

Вопрос 4			
Верно			
Баллов: 1,00 из 1,00			
При контакте двух полупроводников различного типа проводимости условие равновесия в области контакта достигается при			
Выберите один или несколько ответов:			
☑ выравнивании уровней Ферми обоих полупроводников ✔			
установлении уровня Ферми в n-полупроводнике ниже, чем в p-полупроводнике			
уменьшении тока основных носителей в е раз			
✓ равенстве тока основных и неосновных носителей ✔			
установлении уровня Ферми в n-полупроводнике выше, чем в p-полупроводнике			
Ваш ответ верный.			
Вопрос 5			
Верно			
Баллов: 1,00 из 1,00			

На рисунке представлена ВАХ фотодиода.



Ток диода правее точки в обусловлен...

Ток диода между точками **а - є** обусловлен...

Ток диода левее точки а обусловлен...

основными носителями	~
неосновными носителями	~
неосновными носителями	~

Ваш ответ верный.